

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

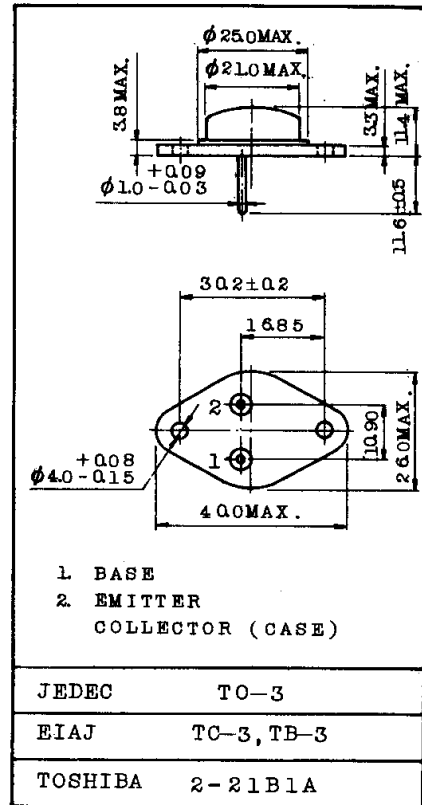
2SC2122
2SC2122A

- テレビ水平偏向出力用
- 大電力スイッチング用
- TV Horizontal Output and High Power Switching Applications
- ・ 高耐圧です; $V_{CBO}=1000V$ (2SC2122A)
800V, (2SC2122)
- ・ 電流容量が大きい; $I_C(\text{peak})=15A$
- ・ スwitching時間が速い; $t_f=1\mu s$ Max.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SC2122A	V_{CBO}	1000	V
	2SC2122		800	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SC2122A	V_{CEO}	400	V
	2SC2122		325	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	8	V
コレクタ電流 (cont.)		I_C	10	A
コレクタ電流 (peak)		I_{CP}	15	A
コレクタ損失		P_C	50	W
接合温度		T_j	150	$^\circ C$
保存温度		T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリは AC42C を適用
MOUNTING KIT No. AC42C

2SC2122

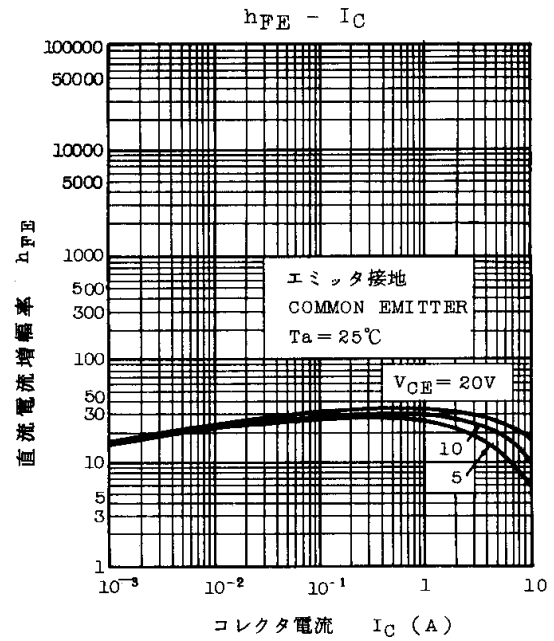
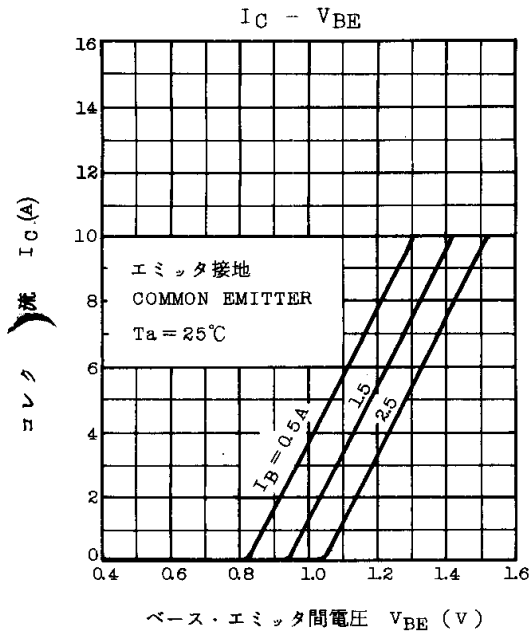
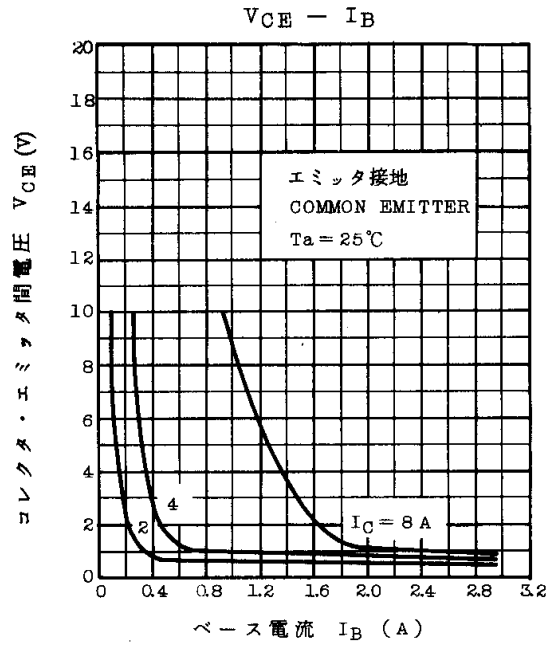
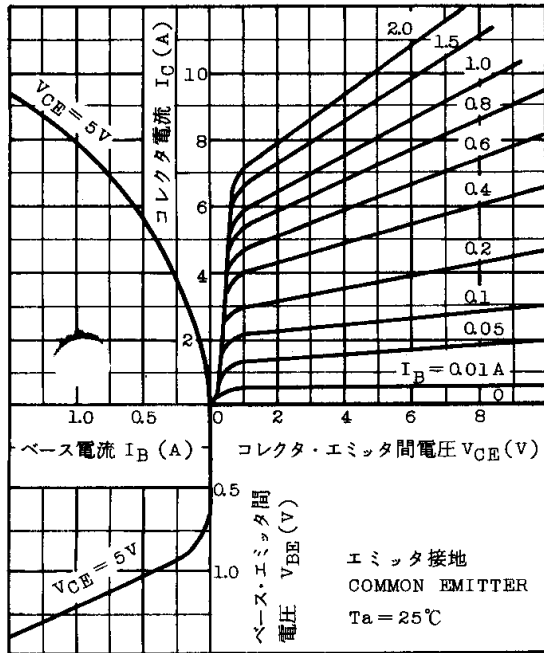
2SC2122A

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタ・ベース間降伏電圧	2SC2122A	V _{(BR)CBO}	I _C =1mA	1000	—	—	V
	2SC2122			800	—	—	
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SC2122A	V _{(BR)CEO}	I _C =50mA	400	—	—	V
	2SC2122			325	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧		V _{(BR)EBO}	I _E =10mA	8	—	—	V
コレクタレキ断電流	2SC2122A	I _{CEX}	V _{CB} =1000V	—	—	1	mA
	2SC2122		V _{CB} =800V				
直流電流増幅率		h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =2.5A	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		V _{CE(sat)}	I _C =8A, I _B =2.5A	—	—	3.3	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		V _{BE(sat)}	I _C =8A, I _B =2.5A	—	—	2.2	V
トランジション周波数		f _T	V _{CE} =10V, I _C =0.1A	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量		C _{ob}	V _{CB} =20V, I _E =0, f=1MHz	—	125	—	pF
下降時間		t _f	I _C =8A, I _{B1} (end)=2.5A I _{B2} =2.5A	—	—	1	μs

2SC2122 2SC2122A

STATIC CHARACTERISTIC



2SC2122

2SC2122A

